**浙江大学杭州国际科创中心**

**青年人才卓越计划申报表**

**浙江大学杭州国际科创中心**

 年 月 日

**一、个人基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| 学位 |  | 职 称 |  |
| 电话 |  | 手 机 |  |
| 主要研究领域 |  |
| 电 子 邮 箱 |  |
| 所在单位 |  |
| 教育经历 | 从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名格式：开始年月-结束年月，机构名，院系，学历，研究生导师姓名（仅指攻读硕士和博士研究生学位阶段导师） |
| 科研与学术工作经历 | 按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名格式：开始年月-结束年月，机构，部门，职称，（如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）  |
| 代表性成果 | （主要介绍科研工作经历及所取得的成绩情况，包括本人在其中所发挥的作用、所取得成果的技术水平，500字以内，相关证明材料作为附件提供。） |
| 获奖情况 | 格式：获奖人(获奖人排名/获奖人数), 获奖项目名称, 奖励机构, 奖励类别, 奖励等级, 颁奖年份 |
| 重要学术任（兼）职 | 国内外重要学术组织（团体）或重要学术刊物等的任职/兼职情况 |
| 其他 | 人才培养、教育教学、主持科研项目及人才计划项目情况(根据实际情况填写)主持项目情况格式：项目类别，批准号，名称，研究起止年月，获资助金额，项目状态（已结题或在研等），主持或参加 |

**二、研究内容简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 研究方向 |  |
| 申请方向 | □宽禁带半导体材料方向：GaN、SiC、Si基III－V、Ga2O3、Diamond、AlN等□宽禁带半导体器件方向：基于SiC、GaN等材料的功率器件、射频器件和芯片集成技术等□封装测试方向：功率器件、射频器件及其他器件相关的封装、模块集成和测试应用技术等□新兴与交叉学科方向 |
| 研究背景、内容与研究目标 | (包括研究目标、研究内容、进度计划、考核指标等内容，限1500字以内) |
| 关键词（用分号分开，最多5个） |  |

**三、签章页**

|  |  |
| --- | --- |
| 本人承诺 | 本人承诺以上信息真实有效。 签字： 年 月 日 |
| 推荐意见 | 推荐意见（推荐信可作为附件附后，若无推荐意见此项可不填写）： 推荐人签字（签章）   年 月 日 |

**代表性成果附件：**

**一、期刊和会议论文**

要求：

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“\*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

CCF A类和B类分别以二级标题列出。

**二、专著**

格式：所有作者, 专著名称(章节标题), 出版社, 总字数, 出版年份。

**三、授权发明专利**

格式：发明人, 专利名称, 授权时间, 国别, 专利号

**四、会议特邀学术报告**

格式：报告人, 报告名称, 会议名称, 会议地址, 会议时间